

Этикетка

КСНЛ.431279.008 ЭТ

Микросхема 1564ЛП23ТЭП

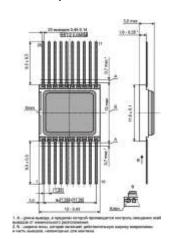
Микросхема интегральная 1564ЛП23ТЭП

Функциональное назначение:

Четыре элемента мажоритарной логики «2 из 3» с тремя состояниями на выходах

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов Номера выводов показаны условно



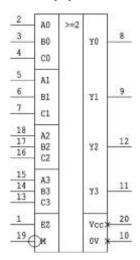


Таблица назначения выводов

| № | Обозначение | Назначение вывода | N₂ | Обозначение | Назначение |
|--------|-------------|--|--------|-------------|---|
| вывода | вывода | | вывода | вывода | вывода |
| 1 | EZ | Вход управления тре- тьим состоянием выхода | 11 | Y3 | Выход четвертого канала |
| 2 | A0 | Первый вход данных первого канала | 12 | Y2 | Выход третьего канала |
| 3 | В0 | Второй вход данных первого канала | 13 | C3 | Третий вход данных четвертого канала |
| 4 | C0 | Третий вход данных первого канала | 14 | В3 | Второй вход данных четвертого канала |
| 5 | A1 | Первый вход данных второго канала | 15 | A3 | Первый вход данных четвертого канала |
| 6 | B1 | Второй вход данных второго канала | 16 | C2 | Третий вход данных третьего канала |
| 7 | C1 | Третий вход данных второго канала | 17 | B2 | Второй вход данных третьего канала |
| 8 | Y0 | Выход первого канала | 18 | A2 | Первый вход данных третьего канала |
| 9 | Y1 | Выход второго канала | 19 | M | Вход управления |
| 10 | 0V | Общий | 20 | V_{cc} | Питание |

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при t = 25+10 °C)

| 1.1 Основные электрические параметры (при $t = 25\pm10$ °C) | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|--|
| | Буквенное | Норма | | |
| Наименование параметра, единица измерения, режим измерения | обозначение | не менее | не более | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: | | | | |
| U_{CC} =2,0 B, U_{IL} =0,3 B, U_{IH} =1,5 B I_{O} = 20 MKA | $U_{OL\;max}$ | - | 0,10 | |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B I_{O} = 20 мкА | | - | 0,10 | |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 20 MKA | | - | 0,10 | |
| при: | | | | |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B, I_{O} =6,0 mA | | - | 0,26 | |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 5,2 mA | | - | 0,26 | |
| 2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: | | | | |
| $U_{CC}=2.0 \text{ B}, U_{IL}=0.3 \text{ B}, U_{IH}=1.5 \text{ B} I_{O}=20 \text{ MKA}$ | U_{OHmin} | 1,9 | - | |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B I_{O} = 20 MKA | | 4,4 | - | |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 20 MKA | | 5,9 | - | |
| при: | | | | |
| U_{CC} =4,5 B, U_{IL} =0,9 B, U_{IH} =3,15 B, I_{O} =6,0 mA | | 4,0 | - | |
| U_{CC} =6,0 B, U_{IL} =1,2 B, U_{IH} =4,2 B, I_{O} = 5,2 mA | | 5,5 | - | |
| 3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: | | | | |
| U_{CC} = 6,0 B, U_{IL} = 0 B, U_{IH} = U_{CC} | ${ m I}_{ m IL}$ | - | /-0,1/ | |
| 4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: | | | | |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = U_{CC}$ | I_{IH} | = | 0,1 | |
| 5. Ток потребления, мкА, при | | | | |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IL} = 0 \text{ B}, U_{IH} = U_{CC}$ | I_{CC} | - | 8,0 | |
| 6. Выходной ток низкого уровня в состоянии «Выключено», мкА, при: | | • | | |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}$ | I_{OZL} | - | /-0,5/ | |

| 7. Выходной ток высокого уровня в состоянии «Выключено», мкА, при: | I_{OZH} | - | 0,5 |
|--|---------------------|---|------|
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, U_{IH} = 4.2 \text{ B}$ | | | · |
| 8. Динамический ток потребления, мА, при: | | | |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, \text{ f} = 10 \text{ M}\Gamma\text{u}$ | I _{OCC} | - | 20,0 |
| 9. Время задержки распространения от выводов А _I , В _I , С _I , до вывода Y ₁ , нс, | | | |
| М=0 при: | t_{PHL1} | | |
| $U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \Pi\Phi$ | t_{PLH1} | - | 96 |
| $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \Pi\Phi$ | | - | 23 |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \Pi \Phi$ | | - | 20 |
| 10. Время задержки распространения от выводов А ₁ , до вывода Y ₁ , нс, | | | |
| М=1 при: | t_{PHL2} | | |
| $U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \Pi\Phi$ | $t_{\rm PLH2}$ | - | 96 |
| $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$ | | - | 23 |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$ | | - | 20 |
| 11. Время задержки распространения от вывода М до вывода Y_1 , нс, при: | | | |
| $U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$ | $t_{ m PHL}$ | - | 120 |
| $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$ | $t_{\rm PLH3}$ | - | 30 |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi$ | | - | 25 |
| 12. Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния | $t_{\rm PLZ}$ | | |
| низкого уровня в состояние «Выключено» и из состояния «Выключено» в | t_{PZL} | | |
| состояние низкого уровня, нс, при: | | | |
| $U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ пФ}, R_{L=}1 \text{ кОм}$ | | - | 96 |
| $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ пФ}, R_{L=}1 \text{ кОм}$ | | - | 23 |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ m}\Phi, R_{L=}1 \text{ kOm}$ | | - | 20 |
| 13. Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния | | | |
| высокого уровня в состояние «Выключено» и из состояния «Выключено» в | t_{PHZ} | | |
| состояние высокого уровня, нс, при: | t_{PZH} | | |
| $U_{CC} = 2.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi, R_{L=}1 \text{ кOm}$ | | - | 96 |
| $U_{CC} = 4.5 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi, R_{L=}1 \text{ кOm}$ | | - | 23 |
| $U_{CC} = 6.0 \text{ B}, C_L = 50 \text{ п}\Phi, R_{L}=1 \text{ кOm}$ | | - | 20 |
| 14. Входная емкость, пФ | C_{I} | - | 10 |

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото г. серебро г. в том числе: г/мм на 20 выводах длиной мм.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых

ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температуре эксплуатации) не более (65+5) $^{\circ}$ C не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при $U_{CC} = 5B \pm 10\%$ - не менее 120000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости ($T_{\text{Су}}$) при γ = 99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных,- в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.424-31ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564ЛП23ТЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-31ТУ и признаны годными для эксплуатации.

| Приняты по (извещение, а | отот(дата) | _ |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| Место для штампа ОТК | | Место для штампа ПЗ |
| Место для штампа « Пер- | епроверка произведена | » (дата) |
| Приняты по(извещение | е, акт и др.) от (дата) | _ |
| Место для штампа ОТК | | Место для штампа ПЗ |

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общий, вход-питание.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ